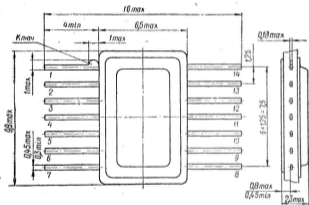


По техническим условиям А0.336.023 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.
 Оформление — в металлическом герметичном корпусе.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высота наибольшая	2,3 мм
Длина наибольшая	9,8 мм
Ширина наибольшая (без выводов)	6,5 мм
Вес наибольший	0,6 г



- 1, 8 — свободные выходы
 3, 6, 10, 13 — эмиттер
 4, 7, 11, 14 — коллектор
 2, 5, 9, 12 — база
 2, 13, 14; 3, 4, 12; 5, 10, 11
 и 6, 7, 9 — единичные транзисторные структуры

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора:		
при температуре $25 \pm 10^\circ$ и минус $45 \pm 2^\circ \text{C}^*$	не более 10 мкА	
» » $85 \pm 2^\circ \text{C} \Delta$	не более 100 мкА	
Обратный ток эмиттера \circ	не более 20 мкА	
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером: \square		
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$	25—150	
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$	25—250	
» » минус $45 \pm 2^\circ \text{C}$	10—150	
Модуль коэффициента передачи тока на частоте 100 МГц \dagger	не менее 2	
Напряжение насыщения \circ :		
коллектор—эмиттер	не более 1,3 В	
база—эмиттер	не более 2,2 В	
Время рассасывания \square	не более 120 нс	
Долговечность	не менее 10 000 ч	

* При напряжении коллектора минус 45 В.

 Δ При напряжении коллектора минус 30 В. \circ При обратном напряжении эмиттера минус 4 В. \square При напряжении коллектора минус 5 В, токе эмиттера 200 мА, на частоте 30 Гц. \dagger При напряжении коллектор—эмиттер минус 10 В и токе коллектора 30 мА. \circ При токе коллектора 400 мА и токе базы 80 мА. \square При токе коллектора 200 мА и токе базы 20 мА.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение коллектор—база* и коллектор—эмиттер $\circ \Delta \circ$:		
при температуре перехода от минус 45 до плюс $70^\circ \text{C} \circ$	минус 45 В	
при температуре перехода 120°C	минус 30 В	
Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база $\square \circ \Delta \square$	минус 4 В	
Наибольший ток коллектора $\square \Delta$:		
постоянный	400 мА	
импульсный \square	600 мА	
Наибольшая суммарная рассеиваемая мощность матрицы при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс $25^\circ \text{C} \nabla$	0,4 Вт	
Наибольшая суммарная импульсная мощность матрицы \square	10 Вт	

Наибольшее общее тепловое сопротивление переход—среда 218 град/Вт

- * Допускается импульсное напряжение до 60 В при длительности импульса не свыше 10 мкс и скважности не менее 10.
- △ Для одной транзисторной структуры.
- При сопротивлении в цепи эмиттер—база 1 кОм.
- ◊ При температуре перехода от 70 до 120° С наибольшее напряжение снижается по линейному закону.
- При температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 85° С.
- ✱ Допускается импульсное напряжение до минус 6 В.
- ▢ При длительности импульса не свыше 10 мкс и скважности не менее 10.
- ▽ При температуре окружающей среды от 25 до 85° С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле

$$P_{k \max} = 0,24 + \frac{85 - t_{\text{окр}}}{218} \text{ (Вт)},$$

где 0,24 Вт — наибольшая рассеиваемая мощность при $t_{\text{окр}} = 85^\circ \text{C}$.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:	
наибольшая	плюс 85° С
наименьшая	минус 45° С
Наибольшая относительная влажность при температуре 40° С	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее	3 ат
наименьшее	203 мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при вибрации*	10 g
линейное	150 g
при многократных ударах	150 g

* В диапазоне частот 1—600 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается пайка и изгиб выводов на расстоянии не менее 1 мм от корпуса матрицы при радиусе изгиба не менее 0,5 мм.

Кручение выводов вокруг оси и изгиб их в плоскости корпуса матрицы запрещается.

Допускается установка матриц на плату и их крепление клеем или лаком.

Необходимо принимать меры по защите транзисторов от статического заряда.

КТС622А
КТС622Б

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ МАТРИЦЫ
p-n-p

Гарантийный срок хранения 6 лет*

* При хранении транзистора в складских условиях в упаковке поставщика, в ЗИПе, а также вмонтированными в аппаратуру, в том числе 1 год хранения в полевых условиях в аппаратуре в ЗИПе, защищенных от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

КТС622Б

Обратный ток коллектора:		
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ и минус $45 \pm 2^\circ \text{C}$ *	не более 20 мкА	
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ Δ	не более 200 мкА	
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:		
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$	не менее 10	
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$	10—250	
» » минус $45 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 5	
Модуль коэффициента передачи тока на частоте 100 МГц	не менее 1,5	
Напряжение насыщения:		
коллектор—эмиттер	не более 2 В	
база—эмиттер	не более 2,5 В	
Время рассасывания	не более 200 нс	
Наибольшее напряжение коллектор—база и коллектор—эмиттер:		
при температуре от минус 45 до плюс 70°C	35 В	
» » 120°C	20 В	

* При напряжении коллектора минус 35 В.

Δ При напряжении коллектора минус 20 В.

Примечание. Остальные данные такие же, как у КТС622А.